PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-097441

(43)Date of publication of application: 02.04.2002

(51)Int.CI.

CO9J201/00 CO9J 9/02 CO9J 11/06 HO1B HO1B H01L 21/60 H01R 4/04 HO5K H05K 3/36

(21)Application number: 2000-286292

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

21.09.2000

(72)Inventor: KATOGI SHIGEKI

YANAGAWA TOSHIYUKI

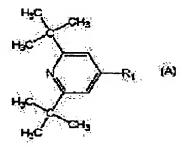
MOCHIDA YUKO YUSA MASAMI

(54) ADHESIVE COMPOSITION, CIRCUIT-CONNECTING MATERIAL, ADHESIVE COMPOSITION FOR CONNECTING CIRCUIT, CONNECTED BODY, AND SEMICONDUCTOR **DEVICE**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an adhesive composition, a circuit-connecting material, an adhesive composition for connecting circuits, and to provide a connected body and a semiconductor device each of which is capable of preventing an adherend composed of a metal and an inorganic material from corroding and of preventing the elements from so decreasing in the reliability as the corrosion proceeds.

SOLUTION: The adhesive composition contains (a) a curable adhesive which is to be cured by the irradiation of light of 150-750 nm wave lengths, heating at 80-200° C, or a combined use of the light irradiation and the heating, and (b) a 2,6-tert-butyl pyridine derivative (s) of formula (A) and/or formula (B).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-97441 (P2002-97441A)

(43)公開日 平成14年4月2日(2002.4.2)

(51) Int.Cl. ⁷	酸別記号	FI	テーマコード(参考)		
C O 9 J 201/00		C 0 9 J 201/00	4 J 0 4 0		
9/02		9/02	5 E 0 8 5		
11/06		11/06	5E319		
H 0 1 B 1/22		H 0 1 B 1/22	D 5E344		
1/24		1/24	D 5F044		
	審査請求	未請求 請求項の数7 OL (全	7 頁) 最終頁に続く		
(21)出顧番号	特願2000-286292(P2000-286292)	(71)出願人 000004455			
		日立化成工業株式会	≩社		
(22) 出顧日	平成12年9月21日(2000.9.21) 東京都新宿区西新宿2 丁目1				
		(72)発明者 加藤木 茂樹			
		茨城県つくば市和台	348 日立化成工業株式		
		会社総合研究所内			
		(72)発明者 柳川 俊之			
		茨城県つくば市和台	348 日立化成工業株式		
		会社総合研究所内			
		(72)発明者 持田 祐子			
		茨城県つくば市和台	348 日立化成工業株式		
		会社総合研究所内			
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 接着剤組成物、回路接続材料、回路接続用接着剤組成物、接続体及び半導体装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 金属及び無機材質で構成される被着体の腐食 およびこれに伴う素子の信頼性低下を防ぐ接着剤組成 物、回路接続材料、回路接続用接着剤組成物、接続体及 び半導体装置を提供する。

【解決手段】 a)150~750nmの光照射または80~200℃の加熱または光照射と加熱を併用することで硬化する硬化性接着剤、b)一般式Aおよび/または一般式Bの2,6一ジーtertーブチルピリジン誘導体化合物とを含有する接着剤組成物。

Ç,

【特許請求の範囲】

【請求項1】 $(a)150\sim750nmの光照射、または80\sim200℃の加熱、または光照射と加熱を併用することで硬化する硬化性接着剤、<math>(b)$ 一般式 (A) および/または一般式 (B) で示される化合物とを含有する接着剤組成物。

【化1】

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 R_1
 CH_3
 CH_3

(ここでR₁は、水素、水酸基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、炭素数1~20のエステル基、炭素数1~20のアルケニル基、アリール基、炭素数1~20のアルコキシ基、炭素数2~20のアルケニルオキシ基、アリールオキシ基、炭素数2~20のアルコキシカルボニル基、炭素数1~20のアルキルチオ基、炭素数1~20のアルキルスルフォニル基、炭素数1~20のアルキルスルフィニル基であり、前記アリール基は、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルキルスルフィニル基であり、前記アリール基は、炭素数1~5のアルキルスルフィニル基であり、前記アリール基は、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のエステル基で置換されていても良い)

【化2】

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 CH_3
 R_2
 R_3
 CH_3
 CH_3

(ここで R_2 は、カルボニル基、カルバメート基、酸素、窒素、硫黄、炭素数 $1\sim20$ のエステル基、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $2\sim20$ のアルケニル基、アリール基、炭素数 $1\sim20$ のアルケニルオキシ基、アリールオキシ基、炭素数 $2\sim20$ のアルカーボニル基、炭素数 $1\sim20$ のアルキルナオ基、炭素数 $1\sim20$ のアルキルスルフォニル基、炭素数 $1\sim20$ のアルキルスルフォニル基、炭素数 $1\sim50$ のアルキル基、炭素数 $1\sim50$ のアルキル基、炭素数 $1\sim50$ のアルキル基であり、前記アリール基は、炭素数 $1\sim50$ のアルキルスルフェニル基で置換されていても良い。 R_3 は、 $2\sim4$ 6の有機基であり、nは $2\sim6$ 0を整数である)

【請求項2】 (a) 硬化性接着剤100重量部に対して、前記(b) 一般式(A) および/または一般式(B) で示される化合物0.5~30重量部含有する請求項1に記載の接着剤組成物。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の接着剤

組成物中に、さらに導電性粒子を含む接着剤組成物。

【請求項4】 請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の接着剤組成物の形状をフィルム状とした回路接続材料。

【請求項5】 相対向する回路電極を有する回路部材間に介在させ、相対向する回路電極を有する回路部材を加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続する接着剤組成物であって、前記接着剤組成物は、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の接着剤組成物または回路接続材料である回路接続用接着剤組成物。

【請求項6】 請求項5に記載の回路接続用接着剤組成物を用いて回路部材を接続した接続体。

【請求項7】 半導体素子の電極と半導体搭載用基板の 回路電極間に請求項1ないし請求項4のいずれかに記載 の接着剤組成物または回路接続材料を介在させ、加圧し て加圧方向の電極間を電気的に接続した半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、接着剤組成物、回路接続材料、回路接続用接着剤組成物、接続体及び半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子及び液晶表示素子において、 素子中の種々の部材を結合させる目的で従来から種々の 接着剤が使用されている。接着剤に対する要求は、接着 性をはじめとして、耐熱性、高温高温状態における信頼 性等多岐に渡る特性が要求されている。また、接着に使 用される被着体は、プリント配線板やポリイミド等の有 機基材をはじめ、銅、アルミニウム等の金属やITO等 の無機材質で形成された回路電極面、シリコンウェハ等 の多種多様な基材が用いられ、各被着体にあわせた分子 設計が必要である。従来から、前記半導体素子や液晶表 示素子用の接着剤としては、高接着性でかつ高信頼性を 示すエポキシ樹脂を用いた熱硬化性樹脂が用いられてき た。樹脂の構成成分としては、エポキシ樹脂、エポキシ 樹脂と反応性を有するフェノール樹脂等の硬化剤、エポ キシ樹脂と硬化剤の反応を促進する熱潜在性触媒が一般 に用いられている。熱潜在性触媒は硬化温度及び硬化速 度を決定する重要な因子となっており、室温での貯蔵安 定性と加熱時の硬化速度の観点から種々の化合物が用い られてきた。実際の工程での硬化条件は、170~25 0℃の温度で1~3時間硬化することにより、所望の接 着を得ていた。また、接着剤を用いた回路電極の接続方 法として、2つの回路基板同士を接着すると共に、これ らの電極間に電気的導通を得る接着剤として、スチレン 系やポリエステル系等の熱可塑性物質や、エポキシ系や シリコーン系等の熱硬化性物質が用いられている。この 場合、接着剤中に導電性粒子を配合し加圧により接着剤 の厚み方向に電気的接続を得るもの (例えば特開昭55 -104007号公報)と、導電性粒子を用いずに接続

時の加圧により電極面の微細凸凹の接触により電気的接 続を得るもの(例えば特開昭60-262430号公 報)とがある。しかしながら、最近の半導体素子の高集 積化、液晶素子の高精細化に伴い、素子間及び配線間ピ ッチが狭小化し、硬化時の加熱によって、周辺部材に悪 影響を及ぼす恐れが出てきた。さらに低コスト化のため には、スループットを向上させる必要性があり、低温 (100~170℃)、短時間(1時間以内、好ましくは 数十秒以下)、換言すれば低温速硬化での接着が要求さ れている。この低温速硬化を達成するためには、活性化 エネルギーの低い熱潜在性触媒を使用する必要がある が、この場合、室温付近での貯蔵安定性を兼備すること が非常に難しい。貯蔵安定性及び低温硬化性を兼備えた 接着剤として、エポキシ樹脂の光カチオン重合を用いる 方法が特開平11-60899号公報及び特開平11-116778号公報に開示されている。これらは、エポ キシ樹脂と光照射によって強酸を発生する光酸発生剤か ら構成されており、室温で光照射することにより硬化を 行う方法である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記光カチオン重合の場合、重合触媒としてブレンステッド酸やルイス酸等の強酸を使用するため、被着体である金属基板や金属及び無機材質で構成される回路電極の腐食を促進し、接続体の信頼性を著しく低下させてしまう問題があった。また、接着剤にエポキシ樹脂を用いた場合、エポキシ樹脂中に残存する不純物イオンが、被着体の銅、アルミニウム等の金属やITO等の無機材質で形成される回路電極の腐食を引き起こし、結果的に接続体としての機能を低下させてしまう。

【0004】本発明は、金属及び無機材質で構成される 被着体の腐食に伴う素子の信頼性低下を防ぎ、さらに室 温での貯蔵安定性に優れる接着剤組成物、回路接続材 料、回路接続用接着剤組成物、接続体及び半導体装置を 提供するものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、[1](a)150~750nmの光照射、または80~200℃の加熱、または光照射と加熱を併用することで硬化する硬化性接着剤、(b)一般式(A)及び/又は一般式(B)で示される化合物とを含有する接着剤組成物である。 【化3】

(ここでR₁は、水素、水酸基、カルボキシル基、シア

ノ基、ニトロ基、炭素数1~20のエステル基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、アリール基、炭素数1~20のアルコキシ基、炭素数2~20のアルケニルオキシ基、アリールオキシ基、炭素数2~20のアルコキシカルボニル基、炭素数1~20のアルキルスルフォニル基、炭素数1~20のアルキルスルフォニル基、炭素数1~20のアルキルスルフィニル基であり、前記アリール基は、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のエステル基で置換されていても良い)

【化4】

$$H_3C$$
 R_2
 R_3
 R_3

(ここでR₂は、カルボニル基、カルバメート基、酸

1~20のアルキル基、炭素数2~20のアルケニル

素、窒素、硫黄、炭素数1~20のエステル基、炭素数

基、アリール基、炭素数1~20のアルコキシ基、炭素 数2~20のアルケニルオキシ基、アリールオキシ基、 炭素数2~20のアルコキシカルボニル基、炭素数1~ 20のアルキルチオ基、炭素数1~20のアルキルスル フォニル基、炭素数1~20のアルキルスルフィニル基 であり、前記アリール基は、炭素数1~5のアルキル 基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のエス テル基で置換されていても良い。R3は、2~4価の有 機基であり、nは2~6の整数である) また、本発明は、[2](a)硬化性接着剤100重量部に 対して、前記(b)一般式(A)および/または一般式 (B)で示される化合物 O.5~30 重量部含有する上 記[1]に記載の接着剤組成物である。また、本発明は、 [3]上記[1]または上記[2]に記載の接着剤組成物中 に、さらに導電性粒子を含む接着剤組成物である。ま た、本発明は、[4]上記[1]ないし上記[3]のいずれか に記載の接着剤組成物の形状をフィルム状とした回路接 続材料である。また、本発明は、[5]相対向する回路電 極を有する回路部材間に介在させ、相対向する回路電極 を有する回路部材を加圧して加圧方向の電極間を電気的 に接続する接着剤組成物であって、前記接着剤組成物 は、上記[1]ないし上記[4]のいずれかに記載の接着剤 組成物または回路接続材料である回路接続用接着剤組成 物である。また、本発明は、[6]上記[5]に記載の回路 接続用接着剤組成物を用いて回路部材を接続した接続体 である。また、本発明は、[7]半導体素子の電極と半導 体搭載用基板の回路電極間に上記[1]ないし上記[4]の いずれかに記載の接着剤組成物または回路接続材料を介 在させ、加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続した 半導体装置である。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において用いる(a) 硬化性接着剤は、150~750 nmの光照射、または80~200℃の加熱、さらには光照射と加熱を併用することで硬化するものであれば特に制限なく、公知のものを使用しうる。このような硬化性接着剤としては例えば、分子内にアクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基、マレイミド基、ビニル基等のラジカル重合性基を一つ以上有する樹脂と熱および/又は光照射によってラジカルを発生する重合開始剤とからなるラジカル重合系が

挙げられる。また、エポキシ樹脂と分子内にフェノール 性水酸基、チオール基、カルボキシル基を少なくとも一 つ以上有する樹脂と硬化促進剤、およびエポキシ樹脂、 ビニルエーテル樹脂等のカチオン重合性樹脂と熱および /又は光照射よってカチオンを発生する重合開始剤とか らなるエポキシ硬化系が挙げられる。

【0007】本発明において用いる(b)一般式(A) および/または一般式(B)で示される化合物としては、下記の化合物(C) \sim (J)が特に好ましい。 【化5】

【0008】(b)一般式(A)および/または一般式(B)で示される化合物の添加量は、(a)硬化性接着 剤100重量部に対して、(b)一般式(A)および/または一般式(B)で示される化合物0.5~30重量部であり、好ましくは1~10重量部である。添加量がこの範囲を超えると、硬化性に悪影響を及ぼす恐れがある。【0009】本発明に用いる導電性粒子としては、Au、Ag、Ni、Cu、はんだ等の金属粒子やカーボン

等が挙げられる。また、非導電性のガラス、セラミック、プラスチック等を核とし、この核に前記金属、金属粒子やカーボンを被覆したものでもよい。導電性粒子が、プラスチックを核とし、この核に前記金属、金属粒子やカーボンを被覆したものや熱溶融金属粒子の場合、加熱加圧により変形性を有するので接続時に電極との接触面積が増加し信頼性が向上するので好ましい。またこれらの導電性粒子の表面を、さらに高分子樹脂などで被

覆した微粒子は、導電性粒子の配合量を増加した場合の 粒子同士の接触による短絡を抑制し、電極回路間の絶縁 性が向上できることから、適宜これを単独あるいは導電 性粒子と混合して用いてもよい。

【0010】この導電性粒子の平均粒径は、分散性、導電性の点から1~18μmであることが好ましい。導電性粒子の使用量は、特に制限は受けないが、接着剤組成物の全量100体積に対して0.1~30体積%とすることがより好ましい。この値が、0.1体積%とすることがより好ましい。この値が、0.1体積%未満であると導電性が劣る傾向があり、30体積%を超えると回路の短絡が起こる傾向がある。なお、体積%は、23℃の硬化前の各成分の体積をもとに決定されるが、各成分の体積は、比重を利用して重量から体積に換算することができる。また、メスシリンダー等にその成分を溶解したり膨潤させたりせず、その成分をよくぬらす適当な溶媒(水、アルコール等)を入れたものに、その成分を投入し増加した体積をその体積として求めることもできる。

【0011】本発明の接着剤組成物には、カップリング 剤等の密着向上剤、レベリング剤などの添加剤を適宜添 加してもよい。

【0012】本発明の接着剤組成物は、増粘化やフィル ム化を目的として、種々のポリマを適宜添加してもよ い。使用するポリマは特に制限を受けないが、(a)硬化 性接着剤、(b)一般式(A)および/または一般式(B) で示される化合物及び導電性粒子に悪影響を及ぼさない ことが必須である。このようなポリマとしては、ポリイ ミド、ポリアミド、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂 やビスフェノールF型フェノキシ樹脂、ビスフェノール A・ビスフェノールF共重合型フェノキシ樹脂等の汎用 フェノキシ樹脂類、ポリメタクリレート類、ポリアクリ レート類、ポリイミド類、ポリウレタン類、ポリエステ ル類、ポリビニルブチラール、SBS及びそのエポキシ 変性体、SEBS及びその変性体などを用いることがで きる。これらは単独あるいは2種類以上を混合して用い ることができる。さらに、これらポリマ中にはシロキサ ン結合やフッ素置換基が含まれていても良い。これら は、混合する樹脂同士が完全に相溶するか、もしくはミ クロ相分離が生じて白濁する状態であれば接着剤組成物 としては好適に用いることができる。上記ポリマの分子 量は大きいほどフィルム形成性が容易に得られ、また接 着剤としての流動性に影響する溶融粘度を広範囲に設定 できる。分子量は特に制限を受けるものではないが、一 般的な重量平均分子量としては5,000~150,0 00が好ましく、10,000~80,000が特に好 ましい。この値が、5,000未満ではフィルム形成性 が劣る傾向があり、また150,000を超えると他の 成分との相溶性が悪くなる傾向がある。使用量としては 前記ラジカル重合系またはエポキシ硬化系100重量部 に対して20~320重量部とすることが好ましい。こ

の使用量が、20重量部未満又は320重量部を超える場合は、流動性や接着性が低下する傾向がある。

【0013】本発明の接着剤組成物は、常温で液状である場合にはペースト状で使用することができる。室温で固体の場合には、加熱して使用する他、溶剤を使用してペースト化してもよい。使用できる溶剤としては、接着剤組成物及び添加剤と反応性がなく、かつ十分な溶解性を示すものであれば、特に制限は受けないが、常圧での沸点が50~150℃であるものが好ましい。沸点が50℃以下の場合、室温で放置すると揮発する恐れがあり、開放系での使用が制限される。また、沸点が150℃以上だと、溶剤を揮発させることが難しく、接着後の信頼性に悪影響を及ぼす恐れがある。

【0014】本発明の接着剤組成物をフィルム状にして 回路接続材料として用いることもできる。接着剤組成物 に必要により溶剤等を加えるなどした溶液を、フッ素樹 脂フィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、離 形紙等の剥離性基材上に塗布し、あるいは不織布等の基 材に前記溶液を含浸させて剥離性基材上に載置し、溶剤 等を除去してフィルムとして使用することができる。フィルムの形状で使用すると取扱性等の点から一層便利で ある。

【0015】本発明の接着剤組成物は光照射、加熱、または光照射と同時に加熱及び加圧を併用して接着させてることができる。これらを併用することにより、より低温短時間での接着が可能となる。光照射は、150~750nmの波長域の照射光が好ましく、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、キセノンランプ、メタルハライドランプを使用して0.1~10J/cm²の照射量で硬化することができる。加熱温度は、接着剤組成物の分解点以下であれば特に制限は受けないが、80~200℃の温度が好ましい。圧力は、被着体に損傷を与えない範囲であれば、特に制限は受けないが、一般的には0.1~10MPaが好ましい。これらの加熱及び加圧は、0.5秒~3時間の範囲で行うことが好ましい。

【0016】本発明の接着剤組成物は、熱膨張係数の異なる異種の被着体の接着剤として使用することができる。具体的には、異方導電接着剤、銀ペースト、銀フィルム等に代表される回路接続材料、CSP用エラストマー、CSP用アンダーフィル材、LOCテープ等に代表される半導体素子接着材料として使用することができる。

【0017】以下に、本発明の回路接続用接着剤組成物及び接着剤組成物をフィルムとした回路接続材料を用いた電極の接続の一例について説明する。接着剤組成物をフィルム形状とした回路接続材料を、基板上の相対時する電極間に存在させ、150~750nmの光を照射した後、加熱加圧することにより両電極の接触と基板間の接着を得、電極との接続を行える。電極を形成する基板としては、半導体、ガラス、セラミック等の無機質、ポ

リイミド、ポリカーボネート等の有機物、ガラス/エポキシ等のこれら複合の各組み合わせが適用できる。本発明の回路接続用接着剤組成物を用いると、従来困難であった、熱膨張係数が大きく異なる材質の接続が可能となるとともに、被着体の腐食に伴う素子の信頼性低下を防止できることから、広範な材料の接続へ応用できる。

【0018】本発明において、回路部材としては半導体チップ、抵抗体チップ、コンデンサチップ等のチップ部品、プリント基板等の基板、ポリイミドやポリエステルを基材としたフレキシブル配線板、液晶パネル等ガラス上に酸化インジウムースズ(ITO)やクロム、アルミニウム等で配線した透明電極等が用いられる。本発明の接着剤組成物、回路接続用接着剤組成物は、比較的低温での接続が可能なため、接続時に熱応力が小さく、微細回路接続後の信頼性を飛躍的に向上でき、マージンを大きくとれるので、回路の接続作業の効率が向上し、かつ歩留まりも向上する。また、電極の腐食を防止することができるため、微細回路接続後の信頼性を飛躍的に向上できる。

[0019]

【実施例】以下に、本発明を実施例に基づいて具体的に 説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。 【0020】(実施例1)フェノキシ樹脂(PKHC、 ユニオンカーバイド社製商品名、平均分子量45,00 0)40gを、メチルエチルケトン60gに溶解して、 固形分40重量%の溶液とした。エポキシ樹脂として、 ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂 (エピコート82) 8、油化シェルエポキシ株式会社製商品名、エポキシ当 量184)を用い、潜在性触媒として芳香族スルホニウ ム塩(サンエイドSI-100L、三新化学工業株式会社 製商品名)、一般式(A)および/または一般式(B)で 示される化合物として2,6-ジ-tert-ブチル-4 -メチル ピリジン(DtBMP、アルドリッチ社製)を用いた。ま たポリスチレンを核とする粒子の表面に、厚み0.2μ mのニッケル層を設け、このニッケル層の外側に、厚み 0.02μmの金層を設け、平均粒径5μm、比重2、

5の導電性粒子を作製した。 固形重量比でフェノキシ樹 脂 50、エポキシ樹脂 50、潜在性触媒 3、Dt BMP 2となるように配合し、さらに導電性粒子を 1. 5体積%配合分散させ、厚み80μmのフッ素樹脂 フィルムに塗工装置を用いて塗布し、70℃、10分の 熱風乾燥によって接着剤層の厚みが40μmのフィルム 状接着剤を得た。上記製法によって得たフィルム状接着 剤を用いて、厚み0.7mmのコーニングガラス(#70 59、コーニング社製)と、プリント基板上にライン幅 100μ m、ピッチ 200μ m、厚み 35μ mの銅回路 を櫛型状に形成した櫛型電極とを、熱圧着装置(加熱方 式:コンスタントヒート型、東レエンジニアリング株式 会社製)を用いて150℃、2MPaで20秒間の加熱 加圧を行って幅2mmにわたり接続し、時間経過後圧力 開放して、接続体を作製した(図1参照)。この時、あら かじめ櫛型電極上に、フィルム状回路接続材料の接着面 を貼り付けた後、70℃、0.5MPaで5秒間加熱加 圧して仮接続し、その後、フッ素樹脂フィルムを剥離し てもう一方の被着体であるコーニングガラスと接続し

【0021】(比較例1) DtBMPを含有していない他は実施例1と同様にフィルム状接着剤を調整し、櫛型電極とコーニングガラスを加熱圧着により接続体を作製した。

【0022】実施例1、比較例1で作製した接続体について接続直後の初期抵抗及び85℃、85%RHの条件で100時間、100Vの電圧を印加しながら高温高湿状態に曝した後の絶縁抵抗を評価した。絶縁抵抗の評価は、前記接続体に100Vの電圧を60秒間印加した後の抵抗値を絶縁抵抗計(株式会社アドバンテスト製R8340)で測定し、隣接回路間の抵抗50点の平均とした。また、金属顕微鏡を用いて、接続直後と耐湿試験後の外観を観察した。その結果を表1に示した。

[0023]

【表1】

	絶縁抵抗(Ω)		外観		
項目	接続直後	耐湿試験 100 b 後	接続直後	耐湿試験 100 h 後	
実施例 1	5.6×10 ¹¹	3.5×10 ¹¹	良好	良好	
比較例1	6.8×10 ¹¹	2.7×10 ⁸	 良好	電極が腐食	

【0024】実施例1で得た接続体については、耐湿試験後も初期の絶縁抵抗を持続しており、かつ外観の変化も無く、良好な接着剤であることを示した。これに対して、DtBMPを添加していない比較例1の場合、耐湿試験後の絶縁抵抗は初期の絶縁抵抗を維持できずに低い値となり、かつ電極の腐食が観察され、信頼性が低いことが分かる。

【0025】(実施例2)実施例1のフィルム状接着剤を用いて、金バンプ(高さ:30 μ m、バンプ数:184)付きチップと、Ni/Auめっき朝回路プリント基板(電極高さ:20 μ m、基板厚み0.8mm)との接続を以下に示すように行った。フィルム状接着剤の片面を朝回路プリント基板に60 \mathbb{C} 、0.5 M Paの条件で20秒間加熱圧着して、仮接続させた。次に、チップのバンプと朝回

路プリント基板との位置合わせを行い、フィルム状接着 剤のもう一方の面のフッ素樹脂フィルムを剥離して、150℃、50g/バンプ、20秒の条件でチップ上方から加熱圧着して半導体装置を作製した。上記半導体装置を85℃、85%RHの条件で500時間放置した後の接続抵抗を測定したところ、1バンプあたり最高で10mΩ、平均で2mΩであり、良好な接続抵抗を示した。また、チップ及び銅回路プリント基板を剥離して外観を観察したところ、回路基板上の電極及びチップ上のバンプの腐食等は認められず、良好であった。

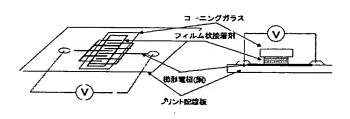
[0026]

【発明の効果】本発明によれば、接着剤中に酸が存在しても回路電極の腐食が無く、しかも低温短時間で接着可能となり、接続信頼性に優れる。また、貯蔵安定性に優れる接着剤組成物、回路接続材料、回路接続用接着剤組成物を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1の試験方法を説明するための模式図。

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FΙ			(参考)
H01L	21/60	3 1 1	H01L	21/60	311S	5G301
H01R	4/04		H01R	4/04		
H O 5 K	3/32		H05K	3/32	В	
	3/36			3/36	Α	

(72)発明者 湯佐 正己

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式 会社総合研究所内 Fターム(参考) 4J040 DD071 DF041 DF051 DM011

ED001 EE061 EF001 EG001 EH031 GA03 GA07 GA29

HA066 HA346 HA366 HC22 HD02 HD11 HD16 JB02 JB08

JB10 KA07 KA32 LA01 LA03

ODIO MAOI MASE ENOT LAOS

LA05 LA09 MA01 MA02 NA20

5E085 DD05 EE34 JJ06

5E319 AA03 AB05 AC01 BB11 CC12

CC61 CD04 CD26 GG15

5E344 AA01 AA22 BB02 BB04 CD02

DD06 EE21

5F044 LL07 LL09

5G301 DA03 DA05 DA06 DA10 DA18

DA29 DA42 DD03